

Heterostructural control of metal chalcogenide nanoparticles

著者	猿山 雅亮
内容記述	Thesis (Ph. D. in Science)--University of Tsukuba, (A), no. 5632, 2011.3.25 Includes bibliographical references
発行年	2011
URL	http://hdl.handle.net/2241/113128

らは、両端の PdS_x 相はアモルファスであり、中央の Co_9S_8 相は結晶構造を持つことが確認された。また、 PdS_x 相と Co_9S_8 相の界面は必ず Co_9S_8 相の $\{001\}$ 面であった。形成メカニズムについて検討したところ、まず PdS_x 粒子上で Co_9S_8 相が成長することでナノどんぐりが生成し、その後ナノどんぐりの Co_9S_8 相同士が融合し、ナノピーナッツが生成することが分かった。同様の手法を用いて、 PdS_x ナノ粒子への CdS 相の成長を試みところ、 $\text{Pd}_x\text{Cd}_y\text{S}$ 相を中心に 1~4 つの CdS 相が成長した花型のヘテロ構造ナノ粒子が得られた。 PdS_x 種粒子はアモルファスであるにもかかわらず、反応後のコア相が結晶性なのは、 Cd^{2+} イオンが PdS_x 粒子に拡散し、熱による結晶構造変態が生じたためと考えられる。 CdS と Pd 種の接合が容易に形成することが明らかとなったので、さらなる新規異方性相分離構造の創製を目的に、 CdS ナノ粒子を種に用いた seed-mediated 成長法を行ったところ、2 つの CdS 相が 1 つの PdS_x 相で結び付けられたダンベル型のヘテロ構造ナノ粒子が選択的に得られた。 $\text{CdS/PdS}_x/\text{CdS}$ ダンベル構造は、2 つの CdS/PdS_x ダイマー構造の PdS_x 相同士が融合して形成することも明らかにした。ロッド状の CdS 種ナノ粒子を用いると、ロッド端に PdS_x 相が成長し、その後の PdS_x 相の融合によってロッドが主に長軸方向につながれた鎖型のナノ構造体を得ることができた。このように、seed-mediated 成長法を利用することにより、種粒子の化学種や形状に依存したヘテロ構造ナノ粒子を選択的に合成できることを示すことができた。

金属カルコゲニドヘテロ構造ナノ粒子を得るもう一つの方法として、イオン交換反応が挙げられる。そこで、タイプ II 型ヘテロ接合を持ち、電荷分離状態を作りやすい CdS/CdTe ヘテロ構造ナノ粒子の合成を目的に、 CdS ナノ粒子の Te によるアニオン交換反応を行い、それに伴う粒子の構造変化、反応メカニズム、光学特性について詳細に検討を行った。粒径 ~ 10 nm の $w\text{-CdS}$ ナノ粒子のオレイルアミン溶液を 260°C に加熱したところにテルル化トリ- n -オクチルホスフィン ($\text{TOP}=\text{Te}$) を加えると、反応溶液は CdS 由来の黄色から CdTe 由来の黒色へと徐々に変化し、アニオン交換が進行した。結晶構造の時間変化を XRD で追跡すると、 $w\text{-CdS}$ 由来のピーク位置に変化はなく、新たに出現したピークは純粋な $zb\text{-CdTe}$ に帰属できることから、アニオン交換中 CdS と CdTe は混ざり合わずほぼ完全に相分離しており、界面が $w\text{-CdS}(002)/zb\text{-CdTe}(111)$ になるように構造緩和することで相分離構造が形成していることが明らかになった。部分的アニオン交換によって合成した CdS/CdTe ヘテロ構造ナノ粒子内の励起キャリアダイナミクスを調べるために、フェムト秒過渡吸収スペクトルを測定したところ、 CdS が吸収できない 600 nm のポンプ光を用いた過渡吸収測定では、 CdS のバンドギャップエネルギーにおいてブリーチングが生じた。このことは CdS の伝導帯に電子が生成したことを示しており、ポンプ光を吸収した CdTe 中の励起電子の CdS への移動、および CdTe (価電子帯) \rightarrow CdS (伝導帯) の間接遷移によって CdTe^+-CdS の電荷分離状態が形成したと考えられる。ヘテロ接合の形成が CdTe/CdS 間の効率的な電子移動を可能にしていることが明らかになり、 $w\text{-CdS}/zb\text{-CdTe}$ ヘテロ構造ナノ粒子は高効率な光触媒や太陽電池への応用が期待できる。

審 査 の 結 果 の 要 旨

本論文では、Ostwald ライプニングによる Cd カルコゲニドナノ粒子の劇的な構造変態法の開発に成功した。また、seed-mediated 成長法を駆使することにより、複数成分からなる様々な金属カルコゲニドヘテロ構造ナノ粒子構造制御を行い、種粒子の化学種や形状に依存したヘテロ構造ナノ粒子を選択的に合成できることを明らかにした。さらに、金属カルコゲニドナノ粒子のアニオン交換反応により CdS/CdTe ヘテロ構造ナノ粒子の合成・同定、ならびに、 CdS/CdTe ヘテロ接合界面を通した空間電荷分離に成功し、金属カルコゲニドナノ粒子の高効率光触媒や光電変換材料への応用を大きく前進させたと考えられる。これらの研究成果は大きな学術的貢献であり、物理化学分野の新しい可能性を切り開いた極めて価値の高い論文である。

よって、著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。